¹⁶⁷Er³⁺:Y₂SiO₅におけるスピン状態保存の為の長コヒーレンス準位の探索

Exploration of hyperfine states with long coherence for spin-state storage in ¹⁶⁷Er³⁺:Y₂SiO₅

北大工¹,北大院工²,日本大³

○松浦 求磨¹, 安井 翔一郎², 鍜治 怜奈², 俵 毅彦³, 足立 智²

Fac. Eng. Hokkaido Univ.¹, Grad. Sch. Eng., Hokkaido Univ.², Nihon Univ.³

K. Matsuura¹, S. Yasui², R. Kaji², T. Tawara³, S. Adachi²

E-mail: qmamatsuura@eis.hokudai.ac.jp

【はじめに】近年,広域量子情報ネットワーク構築のための量子メモリの研究が盛んである.特に通信 波長帯光子と相互作用するエルビウム (Er) 添加結晶は既存ネットワークインフラの光ファイバー網を 活用できるため,量子メモリに有望な固体材料の中でも注目されている.我々も同位体純化した

¹⁶⁷Er³⁺:Y₂SiO₅(YSO)結晶 [1]を用いて、コヒーレンス時間等の基礎 物性値測定 [2],原子周波数コム量子メモリプロトコルの実証と高 効率化 [3]を行なってきた.しかし実用的なメモリ時間 (>1 s)を実 現するには、光学遷移を使って書き込まれる量子情報を ¹⁶⁷Er³⁺の 超微細構造 (HF) 準位に転写する必要がある.これを実現し、かつ オンデマンドの読み出しを可能とするプロトコルがスピン状態保 存 (図 1) である.これによりメモリ時間を μ s オーダーの光学遷 移間コヒーレンス T_2^{opt} から秒オーダーの HF 準位間コヒーレンス T_2^{hyp} へ伸長することが可能となる.しかし ¹⁶⁷Er (核スピン量子数 *I*=7/2)は HF 準位間に 120 ものマイクロ波遷移を持ち、どの 2 つ の HF 準位を使うかで T_2^{hyp} は大きく異なる.本研究では、ホスト 結晶 YSO からの磁気ノイズに不敏感であり、かつ長い T_2^{hyp} を有す る HF 準位を計算により探索することを目的としている.

【結果と考察】 Er^{3+} 周りの Y^{3+} の核スピン揺らぎ(磁気ノイズ) は Er電子のエネルギー準位を変化させると共に, superhyperfine 相互作用を介して Er電子のデコヒーレン スを誘起する. Y^{3+} が作る磁気ノイズ**ΔB**は

$$\Delta \boldsymbol{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \sum_{i=1}^{N} \left[\frac{3(\boldsymbol{\mu}_Y \cdot \boldsymbol{r}_i)\boldsymbol{r}_i}{|\boldsymbol{r}_i|^5} - \frac{\boldsymbol{\mu}_Y}{|\boldsymbol{r}_i|^3} \right]$$

と表せる.上式で r_i は Er^{3+} とその周辺の i 番目の Y^{3+} との距離である.図2の挿入図に示す様に, Er^{3+} 周りには,核スピンをもつ ⁸⁹Y(100%), ²⁹Si(4.7%), ¹⁷O(0.04%)があるが,存在比から Y^{3+} の影響が大きいと考えられる. Y^{3+} の磁気モーメント μ_Y の方向をランダムに設定して, ΔB を50万回反復計算した.図2に示す様にサイト1に位置する Er^{3+} が近接のN=100 個の Y^{3+} から受ける ΔB はおよそ~8 μ T であった.周辺の Y^{3+} 数を変えて同様の計算をした結果,近接する~30個の Y^{3+} が主に磁気ノイズ生成に寄与していることが分かった.ここで評価した核スピン揺らぎが誘起するデコヒーレンスを回避するためには,Zeeman 分裂エネルギーが磁



図1. パルスシーケンスと ス ピン状態ストレージの概念図.



図2. (D1, D2,b)光学直交座標系での Er 電子が感じる磁気ノイズの大きさと その Y³⁺数依存性. 挿入図:サイト1 Er³⁺周りの原子配置[4].

場に対して緩やかな準位対を用いる必要がある.講演ではスピンハミルトニアンを用いた HF 準位構造 計算も交え, *T*^{hyp}の長時間化の展望について議論する.

[1] T. Tawara *et al.*, Appl. Phys. Express **10**, 042801 (2017). [2] S. Yasui *et al.*, Opt. Express **29**, 27137 (2021).
[3] S. Yasui *et al.*, Opt. Cont. **1**, 1896 (2022). [4] B. Car *et al.*, PRB **102**, 115119 (2020).